

2SC644

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ型/Si NPN Epitaxial Planar

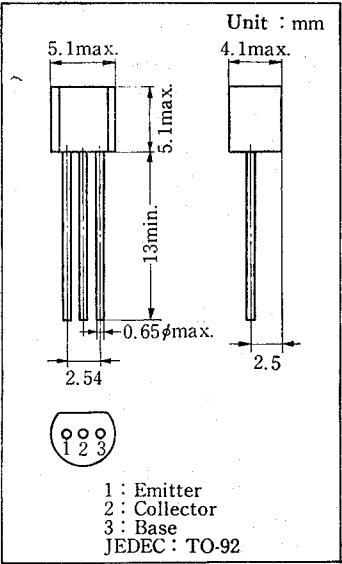
低周波低雑音一般増幅用/AF Low Noise Amplifier

特 徴 / Features

- 雑音指数 NF が低い。/Low noise figure
- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きい。/Large h_{FE}

最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	25	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	100	mA
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
接合部温度	T_j	125	$^{\circ}\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55\sim+125$	$^{\circ}\text{C}$



電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$	30			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=2\text{mA}$, $I_B=0$	25			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$	5			V
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$			1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CB}=5\text{V}$, $-I_E=2\text{mA}$	180		700	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CB}=5\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$			0.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=50\text{mA}$, $I_B=5\text{mA}$		0.14		V
雑音指数	NF	$V_{CB}=5\text{V}$, $-I_E=0.2\text{mA}$, $R_g=2\text{k}\Omega$, $f=100\text{Hz}$			5	dB
		$V_{CB}=5\text{V}$, $-I_E=0.2\text{mA}$, $R_g=2\text{k}\Omega$, $f=1\text{kHz}$			3	

* h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

h_{FE}	180~360	260~520	360~700
分類	R	S	T